1D07 有機 EL 錯体 Bis[2-(o-hydroxyphenyl)benzoxazole] Zinc(II)の電子構造:

~ 置換基と溶媒効果(2)~

(九大院総理工) 〇森 寛敏, 近藤真之, 三好永作

E-mail:moril@asem.kyushu-u.ac.jp

§1.序・目的 電圧を印加すると発光を生じる有機 EL 分子は,高変換効率を示す電気―光変換デ バイスとして注目されている. そのような有機 EL 分子として,我々は筒井らが合成・デバイス特性 評価を行っている Bis[2-(o-hydroxyphenyl)benzoxazole] Zinc(II) (以下 ZnPBO) [1] に注目し,研究を 展開している. ZnPBO EL 錯体系において興味深いのは,配位子 PBO への置換基導入による錯体 幾何構造の変化である. 昨年の本討論会において,我々は,PBO をメチル修飾した場合,2,3Me-PBO は PBO と同様に Zn 錯体が二量化して安定化するのに対し,1Me-PBO では二量化しないことを報 告した [2]. この置換基導入位置の違いによる錯体の幾何構造変化は,1Me 基の立体障害により説明 できる.また,PBO 誘導体 Zn 錯体の幾何構造は溶媒効果によっても変化し,DMSO 溶媒中では 錯体は二量化せずモノマーとして存在する.

つまり, PBO の EL 挙動を制御するためには, 置換基効果,置換基の立体効果,そして溶媒効果 を考慮しなければならない. ZnPBO の EL 挙動 のより深い理解のためには,置換基を変化させた 例をもう少し探る必要があるように思われる.そ こで,今回は,図 2 に示す PBO のフェニル置 換体をターゲットとして研究を行った.



図1 ZnPBO 錯体の青色 EL と 二量化した錯体の構造 [2]

§2. 計算方法 構造最適化を密度汎関数法

(B3LYP/6-31G**) により行った. 続いて振動数解析を行い,理論 IR スペクトルを得た. さらに, NMR スペクトル予測も B3LYP レベルで行い,励起スペクトル予測を TD-B3LYP 法により行った. 溶媒効果の考慮は分極連続体モデル (PCM) により行った.



図2 今回取り扱った PBO 配位子のフェニル拡張系

§3.結果と考察

Zn-PBO 錯体フェニル誘導体の組成式は既知であるが、その幾何構造に関して直接的な情報は全くない.計算結果、得られた二量化によるエネルギー安定化予測値を表1 に示す.

AI ZIFFDU 明件V)――里山による女A			反尼几十八17	、 定 化 工 ハ ハ レ イ (単 位 ・ Kcal IIIOI)		
配位子	PBO04	PBO05	PBO4	PBO5	PBO45	
ΔΕ	14.13	13.65	-14.17	11.48	-10.24	

表1 Zn-PBO 錯体の二量化による安定化エネルギー (単位: kcal mol⁻¹)

表 1 に示したように Zn-PBO フェニル誘導体には二量化により安定化するグループ(赤表示)と, 逆に二量化を起こすとエネルギー的に不利になるためモノマーのまま存在するグループ(青表示)が 存在することが分かった.この結果は,2,3Me 誘導体錯体と 1Me 誘導体錯体の関係によく似た結果 を与えている.この結果は,置換基の立体効果で説明できるだろうか?

図 3 に昨年報告した 1MePBO 配位子の分子式を示す. Me 基の位置 と、今回検討した PBO フェニル拡張系の幾何構造を比べると、二量化 による安定化エネルギーが負になっている PBO4、PBO45 はいずれも、 図2中に青色で示しているようにオキサゾール環の金属へ配位する N 原 子側にフェニル環が拡張されており、1MePBO の Me 基の位置と対応 している. PBO 系有機 EL 錯体の幾何構造は、やはり、置換基の立体 効果により支配されているのである.



図 3 1MePBO の構造

では、置換基の種類による、モノマー/ダイマーの幾何構造の違いは実験的に検出することが可能 であろうか? 基礎データとして ZnPBO モノマーとダイマーの電子構造を図 4 に示す.





図 4 に見られるように、ZnPBO の HOMO・LUMO 軌道エネルギー準位はモノマーとダイマーで 大きく異なり、イオン化ポテンシャルの違いを利用して、錯体幾何構造の検討が可能であると考えら れる. 残りの溶媒効果等の考慮の結果は当日報告する.

【参考文献】[1] 平山 泰子,九大院総理工,修士論文 (2001),[2] 森 寛敏,樗木久之,山本典史,三好永作, 分子構造総合討論会 2004 講演要旨 <u>http://www.nabit.hiroshima-u.ac.jp/bk/4P/4P109.pdf</u>